

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 23 609 A 1**

⑤ Int. Cl.⁸
G 02 B 17/00
G 03 F 7/20

⑳ Aktenzeichen: 199 23 609.7
㉑ Anmeldetag: 25. 5. 99
㉒ Offenlegungstag: 2. 12. 99

DE 199 23 609 A 1

⑧ Innere Priorität:
198 24 442. 8 30. 05. 98

㉑ Anmelder:
Fa. Carl Zeiss, 89518 Heidenheim, DE

㉒ Vertreter:
Dr. Weitzel & Partner, 89522 Heidenheim

㉓ Erfinder:
Dinger, Udo, Dr., 73447 Oberkochen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤ Ringfeld-4-Spiegelsysteme mit konvexem Primärspiegel für die EUV-Lithographie

⑤ Die Erfindung betrifft ein Reduktionsobjektiv, insbesondere der EUV-Mikrolithographie, mit
- vier Multilayer-Spiegeln in zentrierter Anordnung bezüglich einer optischen Achse, mit Primär-, Sekundär-, Tertiär-, Quartärspiegel in dieser Reihenfolge im Strahlengang,
- Ringfeld geeignet für Scanning-Betrieb,
- obskurationsfreier Lichtführung.
Die Erfindung ist gekennzeichnet durch
- einen konvexen Primärspiegel,
- positive Hauptstrahlwinkelvergrößerung des Sekundärspiegels.

DE 199 23 609 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Reduktionsobjektiv gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, eine Belichtungsanlage gemäß Ansprüchen 11 und 12 sowie ein Chipherstellungsverfahren gemäß Anspruch 13.

- 5 Die Lithographie mit Wellenlängen < 193 nm, insbesondere die EUV-Lithographie mit $\lambda = 11$ nm bzw. $\lambda = 13$ nm werden als mögliche Techniken zur Abbildungen von Strukturen < 130 nm, besonders bevorzugt < 100 nm diskutiert. Die Auflösung eines lithographischen Systems wird durch nachfolgende Gleichung beschrieben:

$$10 \quad RES = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

wobei k_1 ein spezifischer Parameter des Lithographieprozesses, λ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes und NA die bildseitige, numerische Apertur des Systems bezeichnet.

- 15 Für abbildende Systeme im EUV-Bereich stehen als optische Komponenten im wesentlichen reflektive Systeme mit Multilayer-Schichten zur Verfügung. Als Multilayer-Schichtsysteme finden bei $\lambda = 11$ nm bevorzugt Mo/Be-Systeme und bei $\lambda = 13$ nm Mo/Si-Systeme Verwendung.

- Legt man eine numerische Apertur von 0,10 zugrunde, so erfordert die Abbildung von 100 nm-Strukturen mit 13 nm-Strahlung einen Prozeß mit $k_1 = 0,77$. Mit $k_1 = 0,64$ wird bei 11 nm-Strahlung die Abbildung von 70 nm-Strukturen möglich.

Da die Reflektivität der eingesetzten Multilayer-Schichten nur im Bereich von ungefähr 70% liegt, ist es bei den Projektionsobjektiven für die EUV-Mikrolithographie von ganz entscheidender Bedeutung, zum Erreichen einer ausreichenden Lichtstärke mit möglichst wenig optischen Komponenten im EUV-Projektionsobjektiv auszukommen.

- Besonders bevorzugt haben sich mit Blick auf eine hohe Lichtintensität und ausreichende Möglichkeiten zur Korrektur von Abbildungsfehlern bei NA = 0,10 Systeme mit vier Spiegeln herausgestellt.

Weitere Anforderungen an ein EUV-Projektionsobjektiv für die EUV-Lithographie betreffen Obskurationen, Bildfeld, Verzeichnung, bild- und objektseitige Telezentrie, den freien Arbeitsabstand sowie die Blende.

Obskurationen, z. B. Mittenabschattungen wie in Schwarzschildsystemen, sind nicht zulässig, da es sonst zu intolerablen Degradationen der Abbildungsgüte kommt.

- 30 Fordert man einen obskurationsfreien Strahlengang so resultiert bei zentrierten Systemen ein außeraxiales Bildfeld. Um Bildformate von 26×34 mm² bzw. 26×52 mm² bereitzustellen, ist es vorteilhaft die Systeme als Ringfeldscanner auszubilden. Die nutzbare Sekantenlänge des Scanschlitzes beträgt dann mindestens 26 mm. Die Ringbreite sollte um eine homogene Beleuchtung bzw. Belichtungs-Kontrolle und "Dose-Control" zu ermöglichen im Bereich 0,5–2 mm liegen.

- Bei der Verzeichnung unterscheidet man zwischen statischer und dynamischer oder Scan-Verzeichnung. Die Scanverzeichnung ist die effektive, sich durch Integration der statischen Verzeichnung über den Scanweg ergebende Verzeichnung. Grenzen für die maßstabskorrigierte, statische Verzeichnung ergeben sich im wesentlichen aus den Spezifikationen für Kontrast und CD-Variation.

- Es ist bildseitige Telezentrie erforderlich. Handelt es sich bei dem Projektionssystem um ein System mit einer Reflektionsmaske, so ist ein telezentrischer Strahlengang objektseitig nicht möglich. Werden Transmissionsmasken, z. B. Stencilmasken, eingesetzt ist auch ein telezentrischer Strahlengang realisierbar.

Um saubere Bündelbegrenzungen zu ermöglichen ist es vorteilhaft, wenn die Blende physikalisch zugänglich ist.

- Die bildseitige Telezentrieforderung bedeutet, daß die Eintrittspupille des letzten Spiegels in oder nahe seines Brennpunktes, zu liegen kommt. Um ein kompaktes Design bei zugänglicher Blende zu erhalten, bietet es sich an, den vorletzten Spiegel als bündelbegrenzendes Element dort zu platzieren.

Aus nachfolgenden Veröffentlichungen sind 4-Spiegel-Projektions- bzw. Reduktionsobjektive bekanntgeworden:

- US 5 315 629
- EP 0 480 617
- 50 - US 5 063 586
- EP 0 422 853
- Donald W. Sweeney, Russ Hudyma, Henry N. Chapman, David Shafer, EUV optical Design for a 100 nm CD Imaging System, 23rd International Symposium of microlithography, SPIE, Santa Clara, California, February 22–27, 1998, SPIE Vol. 3331, p. 2ff.

- 55 In der US 5 315 629 wird ein 4-Spiegel-Projektionsobjektiv mit NA = 0,1, 4x, $31,25 \times 0,5$ mm² beansprucht. Die Spiegelfolge ist konkav, konvex, konkav, konkav.

Aus der EP 0 480 617 B1 sind zwei NA=0,1, 5x, 25×2 mm²-Systeme bekanntgeworden. Die Spiegelfolge ist konkav, konvex, beliebig/konvex, konkav.

- 60 Die Systeme gemäß US 5 063 586 und EP 0 422 853 weisen ein rechteckiges Bildfeld, von beispielsweise mindestens 5×5 mm², auf. Die im allgemeinen dezentrierten Systeme sind mit sehr hohen Verzeichnungswerten im %-Bereich behaftet. Die Objektive könnten daher nur in Steppern mit Verzeichnungsvorhalt auf dem Retikel eingesetzt werden. Das hohe Niveau der Verzeichnung macht derartige Objektive allerdings bei den hier diskutierten Strukturbreiten (≤ 130 nm) unpraktikabel. Die Spiegelfolge ist konvex, konkav, konvex, konkav.

- 65 Aus der US 5 153 898 sind pauschal beliebige 3 bis 5-Multilayer-Spiegel-Systeme bekanntgeworden. Die offengelegten Realisierungen beschreiben allerdings durchweg 3-Spiegelsysteme mit Rechteckfeld und kleiner numerischer Apertur NA (NA<0,04). Die Systeme sind daher auf die Abbildung von Strukturen $\geq 0,25$ µm beschränkt.

Betreffend den allgemeinen Stand der Technik wird des weiteren auf T. Jewell: "Optical system design issues in deve-

lopment of projection camera for EUV lithography", Proc.SPIE 2437 (1995) und die darin angegebenen Zitate verwiesen, deren Offenbarungsgehalt vollumfänglich in die Anmeldung mit aufgenommen wird.

Es hat sich bei den bekannten Systemen gemäß der EP 0 480 617 sowie US 5 315 629 und gemäß Sweeney a.a.O. als nachteilig erwiesen, daß der außeraxial genutzte Teil des Primärspiegels mechanisch mit den waferseitigen Sensoraufbauten einer Projektionsbelichtungsanlage in Konflikt gerät, wenn nicht sehr große freie mechanische Arbeitsabstände > 100 mm realisiert werden. Diese Konflikte treten bei Spiegelsegmenten, die "bildfeldnah" plziert sind, erst bei wesentlich geringeren Abständen (≈ 10 mm) auf.

Aufgabe der Erfindung ist es, somit eine für die Lithographie mit kurzen Wellenlängen, ≤ 193 nm, vorzugweise < 100 nm, geeignete Projektionsobjektiveinrichtung anzugeben, die die zuvor erwähnten Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist, mit möglichst wenigen optischen Elementen auskommt und andererseits eine ausreichend große Apertur aufweist und die Telezentricanforderungen sowie sämtliche weitere Anforderung an ein Projektionssystem für Wellenlängen ≤ 193 nm erfüllen.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine Projektionsobjektiv gelöst, das vier Spiegel umfaßt und durch einen konvexen Primärspiegel sowie eine positive Hauptstrahlwinkervergrößerung des Sekundärspiegels gekennzeichnet ist.

Durch die Ausbildung als 4-Spiegel-System werden hohe Transmission bei Wellenlängen im EUV-Bereich erreicht, wenn man eine Reflektivität der Mehrfachsichtsysteme für diese Strahlung mit 70% zugrundelegt. Andererseits können Aperturen im Bereich NA $\approx 0,10$ realisiert werden. Das 4-Spiegel-Objektiv gemäß der Erfindung zeichnet sich somit durch hohe Auflösung, niedrige Fertigungskosten und hohen Durchsatz aus.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Blende auf oder nahe einem Spiegel liegt, insbesondere dem Tertiärspiegel. Die Blende ist dann physikalisch zugänglich, das Design kompakt und abschattungs-frei und die im Meridionalschnitt die Asphäre im oberen und unteren Endpunkt des Nutzbereiches schneidet, wobei der oder die zusätzlichen Spiegel bevorzugt von einer Planfläche abgeleitete asphärische Flächen aufweisen können.

Vorteilhafterweise ist mindestens ein Spiegel ein aktiver Spiegel. In einer Ausführungsform eines 4-Spiegel-Objektives sind der Sekundärspiegel und der Quartärspiegel konkav.

Vorteilhafterweise sind die Multilayer-Spiegel in der Reihenfolge konvexkonkav-konvex-konkav ausgebildet.

Die in dieser Schrift diskutierten Asphäritäten beziehen sich auf die Spitze-Spitze- bzw. peak to valley (PV)-Abweichung A der asphärischen Flächen gegenüber der im Nutzbereich bestpassenden Sphäre.

Diese werden in den Beispielen durch eine Sphäre approximiert, deren Mittelpunkt auf der Figurenachse des Spiegels liegt und die im Meridionalschnitt die Asphäre im oberen und unteren Endpunkt des Nutzbereiches schneidet.

Die Angaben zu den Einfallswinkeln beziehen sich jeweils auf den Winkel zwischen jeweiligen einfallendem Strahl und Flächennormale am Einfallsort. Angegeben ist jeweils der größte Winkel irgendeines Strahles, im allgemeinen eines bündelbegrenzenden Strahles, der an irgendeinem der Spiegel auftritt.

Besonders bevorzugt beträgt der waferseitige optische freie Arbeitsabstand 60 mm. Der retikelseitige freie Arbeitsabstand beträgt mindestens 100 mm.

Die zuvor beschriebenen Objektive können nicht nur für die EUV-Lithographie eingesetzt werden, sondern selbstverständlich auch bei anderen Wellenlängen, ohne daß von der Erfindung abgewichen wird. Praktisch wird das nur bei UV-Wellenlängen im Bereich um 193 nm bei Excimer-Lasern in Betracht kommen.

Um eine beugungsbegrenzte Abbildung zu erreichen, ist mit Vorteil vorgesehen, daß der Design-Anteil des rms-Wellenfrontanteils des Systems höchstens $0,07 \lambda$, bevorzugt $0,03 \lambda$ beträgt.

Vorteilhafterweise sind in den Beispielen der Erfindung die Objektive stets bildseitig telezentrisch ausgebildet.

Bei Projektionssystemen, die mit einer Reflektionsmaske betrieben werden, ist ein telezentrischer Strahlengang ohne Beleuchtung über einen stark transmissionsmindernden Strahlteiler, wie beispielsweise aus der JP-A-95/28 31 16 bekannt, objektseitig nicht möglich. Daher sind die Hauptstrahlwinkel am Retikel so gewählt, daß eine abschattungsfreie Beleuchtung gewährleistet ist.

Bei Systemen mit Transmissionsmaske kann vorgesehen sein, daß das Projektionsobjektiv objektseitig telezentrisch ausgelegt ist.

Im gesamten sollte der Telezentriefehler am Wafer 10 mrad nicht überschreiten, vorzugsweise liegt er bei 5 mrad, besonders bevorzugt bei 2 mrad. Dies stellt sicher, daß sich die Änderung des Abbildungsmaßstabes bzw. der Verzeichnung über den Tiefenschärfenbereich in tolerierbaren Grenzen hält.

Neben der erfindungsgemäßen Reduktions- bzw. Projektionsobjektiveinrichtung stellt die Erfindung auch eine Projektionsbelichtungsanlage, umfassend mindestens ein derartiges Objektiv, zur Verfügung. In einer ersten Ausführungsform weist die Projektionsbelichtungsanlage eine Reflektionsmaske auf, in einer alternativen Ausführungsform eine Transmissionsmaske.

Besonders bevorzugt ist es, wenn die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines außeraxialen Ringfeldes umfaßt und das System als Ringfeldscanner ausgebildet ist. Mit Vorteil ist vorgesehen, daß die Sekantenlänge des Scan-Schlitzes mindestens 26 mm beträgt und die Ringbreite größer als 0,5 mm ist, so daß eine homogene Beleuchtung ermöglicht wird.

Mit dem erfindungsgemäßen Objektiv können des weiteren die asphärischen Abweichungen von der bestpassenden Sphäre gering gehalten werden, so daß die Forderung nach "Beugungsbegrenztheit" und hoher Reflektivität der ML-Spiegel mit den hieraus folgenden extremen Genauigkeitsanforderungen an diese Oberflächen in allen Ortsfrequenzbereichen vom freien Durchmesser der Spiegel bis zu atomaren Dimensionen eingehalten werden können.

Da die Refektivität der Spiegel im EUV-Bereich durch die Belegung der Substrate mit sog. DBRs (verteilte Bragg Reflektoren), auch als Multilayer bezeichnet, erreicht wird, bestehen diese bei $\lambda=13$ nm und für Mo/Si-System aus ca. 40 Schichtpaaren, bei $\lambda=11$ nm aus ca. 70 Schichtpaaren. Die Winkelakzeptanz dieser Systeme liegt damit im Bereich weniger Grad und nimmt mit zunehmendem Einfallswinkel ab. Des weiteren nehmen mit zunehmendem Einfallswinkel auch störende, durch die Vielfachstruktur verursachte Phaseneffekte, zu. Variiert der aufpunktbezogene mittlere Einfallswinkel zu stark über eine Systemfläche, so müssen Schichtpakete mit veränderlicher Dicke aufgebracht werden.

Da sich die erfindungsgemäßen Objektive durch einen geringeren mittleren Einfallswinkel und eine geringe flächen-

spezifische Variation um den mittleren Einfallswinkel auszeichnen, können die oben dargelegten Probleme von Multi-layer-Systemen gering gehalten werden.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Zeichnungen beispielhaft beschrieben werden.

Es zeigen:

- 5 Fig. 1 schematische Darstellung, der in vorliegender Anmeldung verwendeten Systemklassifizierung.
 Fig. 2 Linsenschnitt eines ersten 4-Spiegel-Systems (Typ e_System) nach dem Stand der Technik
 Fig. 3 Linsenschnitt eines zweiten 4-Spiegel-Systems (Typ f_System)
 Fig. 4 Linsenschnitt eines dritten 4-Spiegel-Systems (Typ g_System)
 Fig. 5 ein 4-Spiegel-System vom Typ f mit eingefügtem grazingincidence Spiegel
 10 Bei den in Fig. 1-4 gezeigten Ausführungsbeispielen handelt es sich um zentrierte, bildseitig telezentrische Reduktionssysteme mit Blende auf dem dritten Spiegel M3. In sämtlichen Systemen werden für gleiche Bauelemente gleiche Bezugsziffern verwendet, wobei nachfolgende Nomenklatur verwendet wird:

- 15 - erster Spiegel (M1), zweiter Spiegel (M2)
 - dritter Spiegel (M3), vierter Spiegel (M4)

Die verschiedenen Ausführungsformen lassen sich klassifizieren durch die Primärspiegelvergrößerung $m(M1)$, bzw. durch das Konvergenzverhältnis $v(M1) = -1/m(M1)$ und die Sekundärspiegel-Hauptstrahlwinkelvergrößerungen $\mu(M2)$. Die Nomenklatur erfolgt nach Dietrich Korsch, Reflective optics, Academic Press 1991, S. 41ff, wobei der Offenbarungsgehalt dieser Schrift vollumfänglich in die Anmeldung mit aufgenommen wurde:

	M1	$v(M1)$	$\mu(M2)$
25 typ_a	konkav	$\in]1, \infty[$	$< -\varepsilon_4$
typ_b	plan, konkav	$\in [-1, 1]$	$< -\varepsilon_4$
30 typ_e	konvex	$\in]-\infty, -1[$	$< -\varepsilon_4$
typ_f	konvex	$\in]-\infty, -1[$	$\in]\varepsilon_4, 1-\varepsilon_2[$
35 typ_g	konvex	$\in]-\infty, -1[$	$\in]1+\varepsilon_3, \infty[$

Es gilt:

$\varepsilon_i > 0$ wächst mit der numerischen Apertur NA des Systems, d. h.

$\varepsilon_i = 0 \rightarrow NA = 0$

Eine schematische Darstellung der Systemklassifizierung wie nachfolgend verwendet, ist in Fig. 1 dargestellt.

- 40 Der Begriff Hauptstrahlwinkelvergrößerung bzw. angular magnification bezieht sich nicht auf den Winkel selbst, sondern auf dessen Tangens (siehe Korsch, Reflective optics a.a.O.) Positive Hauptstrahlwinkelvergrößerung bedeutet anschaulich, daß die Neigungen der mit den einfallenden und reflektierten Hauptstrahlen identifizierbaren Geraden bzgl. der optischen Achse gleiches Vorzeichen besitzen, bzw., daß die Eintritts- und Austrittspupillen des betreffenden Spiegels auf der physikalisch gleichen Seite des Spiegels liegen.

- 45 Wie aus Fig. 1 hervorgeht liegen die Typen a, b und e innerhalb eines topologisch zusammenhängenden Gebietes, d. h. die Systeme können innerhalb des Designparametertraumes kontinuierlich ineinander übergeführt werden.

Im Gegensatz hierzu ist dies nicht möglich für je zwei Systeme der Klassen (a, b, e), f und g, wenn Obskurationsfreiheit erfüllt sein soll. Die Balken in Fig. 1 symbolisieren "verbotene" Gebiete, in denen bei endlicher NA eine Abschattung der Lichtbündel durch Spiegel zwingend ist.

- 50 Die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen topologischen Zusammenhangsgebiet wird durch $\mu(M2)$ bestimmt. Die aus der US 531629 bzw. EP 0480617 bekannten Ringfeldsysteme gehören zur Kategorie Typ_e. Typ_b-Systeme vermitteln den kontinuierlichen Übergang zu den Type Systemen, die auch das aus Donald W. Sweeney et. al., 23rd International Symposium of Microlithography a. a. O. bekannte System umfassen.

- Systeme vom Typ f und Typ g sind aus keiner der angegebenen Veröffentlichungen bekannt. Gegenüber der US 5315629 bzw. EP 048 0617 unterscheiden sich die Systeme gemäß Typ f und Typ g durch den konvexen Primärspiegel. Das aus Donald W. Sweeney et. al. 23rd International Symposium of Microlithography a. a. O. bekannte System weist zwar einen konvexen Primärspiegel auf, hat jedoch eine andere Hauptstrahlwinkelvergrößerung an M2, und damit eine andere Strahlführung im System.

- 60 Systeme vom Typ f mit $v(M1) > \text{ca. } -1,5$ führen zu großen Hauptstrahlwinkeln am Retikel und großen Systemdurchmessern. Dadurch wird eine sinnvolle Systemauslegung mit konkavem M1 ($v(M1) > -1$) schwierig.

In der nachfolgenden Tabelle sind typische Funktionsdaten beispielhafter Ausführungsformen der verschiedenen Systemkategorien gegenübergestellt. Die Verzeichnungswerte ergeben sich nach Maßstabskorrektur über das Ringfeld. Beispielhafte Linsenschnitte der den einzelnen Systemklassen zugehörigen Systeme sind in den Fig. 2-5 gezeigt.

65

DE 199 23 609 A 1

	Typ f (94)	Typ_g(68)
M1	konvex	konvex
v(M1)	-2.4	-2.9
μ (M2)	0.6	1.6
NA	0.1	0.1
Red	4x	4x
Ringfeld [mm ²]	26.0x1.0	28.0x1.25
mittl. Ringfeldradius [mm]	25	51
OO' [mm]	1368	1112
FWD [mm]	92	62
CRAO [mm]	∈[-2.1, -2.0]	∈[4.1,4.2]
CRA [mrad]	∈[-0.35,-0.50]	∈[-0.2,0.2]
max. Asph. [μm]	19.6	8.3
AOI max [deg]	14.1	22.0
ΔAOI max [deg]	±2.5	±2.8
WFE max [λrms]	0.029	0.0025
Verzeichnung [nmPV]	7	30

Erklärung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen:

	Bedeutung
M1	Form des Primärspiegel
v(M1)	'convergence ratio' nach Korsch
μ (M2)	'angular magnification' nach Korsch
NA	bildseitige numerische Apertur
Red	Verkleinerungsfaktor=-1/Abbildungsmaßstab
Ringfeld [mm ²]	Sekantentlänge×Ringbreite im Bildfeld
mittl. Ringfeldradius [mm]	Bildfeldradius in der Mitte des Ringfeldes
OO' [mm]	Objekt-Bild-Abstand
FWD [mm]	optisch freier Arbeitsabstand bildseitig
CRAO [deg]	Hauptstrahlwinkel im Objektraum
CRA [mrad]	Hauptstrahlwinkel im Bildraum
max. Asph. [μm]	max. Abweichung der Asphäre vom Hüllkreis über den Nutzbereich des Spiegels
AOI max [deg]	maximaler Einfallswinkel
ΔAOI max [deg]	Variation der Einfallswinkel über den Spiegel
WFE max [λ rms]	maximaler rms-Wellenfrontfehler in Einheiten von λ
Verzeichnung [nm PV]	Spitze-Spitze-Wert der über das Ringfeld maßstabskorrigierten Hauptstrahlverzeichnung

Die Systeme mit konvexem M1 zeigen eine wesentlich höhere Asphärität als die Typ_a-Ausführungen mit konkav-

vom M1.

In Fig. 2 ist der Schnitt eines Typ e-Systems von der Retikelebene 2 bis zur Waferebene 4 gezeigt, wafernächster Spiegel ist der erste Spiegel M1.

Typ_e-Systeme haben die geringste Winkelbelastung auf den Spiegeln M1, M2, M3, M4 was die polarisationsoptischen Eigenschaften des Systems begünstigt. Die hohen Hauptstrahlwinkel an der Retikelebene 2 erfordern aber sehr

Umgekehrt zeigen Typ_g-Systeme, wie beispielhaft im Schnitt der Fig. 4 gezeigt, bei vertretbaren Hauptstrahlwinkeln am Retikel relativ große Winkelbelastungen auf den Spiegeln M1, M2, M3, M4.

Typ_f-Systeme wie beispielhaft in Fig. 3 gezeigt, benötigen die stärksten Asphären, haben dafür aber günstige Winkelerteilungen auf den Spiegeln, M1, M2, M3, M4, und dem Retikel 2. Der sehr geringen Verzeichnung steht ein relativ kleines Bildfeld gegenüber. Die Baulänge ist zwar größer als bei den anderen Systemen, die lange Driftstrecke innerhalb des Objektivs erlaubt andererseits ggf. das Einsetzen von Zusatzkomponenten, z. B. Alignmentsystem, Umlenkspiegel, etc.

Die Typ_f und Typ_g-Systeme, wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt, können sowohl mit positiven, als auch mit negativen Hauptstrahlwinkeln am Retikel 2 realisiert werden. Damit kann eine optimale Geometrie, insbesondere ein vergleichsweise kleiner freier Arbeitsabstand zum Retikel 2, zur Einspiegelung des Lichtes bei Verwendung einer Reflexionsmaske gewählt werden. Bei Verwendung einer Transmissionsmaske läßt sich ein telezentrischer Strahlengang realisieren.

Die Systeme vom Typ_a und Typ_f besitzen relativ lange "Driftstrecken" vor bzw. innerhalb des eigentlichen Spiegel-systems.

Es ist möglich dort grazing-incidence-Spiegel hoher Reflektivität als Korrektur Elemente, z. B. in der Art eines Schmidt-Korrektors oder eines aktiv optischen Korrektursystems einzufügen. Basierend auf den derzeitigen Literaturwerten ergibt sich für molybdänbeschichtete Spiegel bei 13,3 nm und 75° Einfallswinkel eine theoretisch mögliche Reflektivität von ca. 85% für unpolarisiertes Licht. Durch den streifenden Einfall der Bündel kann der ausgeleuchtete Querschnitt in einer Richtung – im Vergleich zu denjenigen auf den benachbarten Spiegeln – sehr groß gemacht werden, was die Auslegung der Korrektur Elemente erleichtert. Die einzelnen Spiegel werden vorzugsweise paarweise mit aufeinander nahezu senkrecht stehenden Flächennormalen ausgestattet, um die Bündel in allen Raumrichtungen mit der gleichen Auflösung manipulieren zu können.

In Fig. 5 ist ein solches Design vom Typ_f mit eingefügtem grazingincidence-Spiegel GIM dargestellt.

Aus nachfolgender Tabelle 1 gehen die Parameter des Systems gemäß Fig. 3 im Code V-Format hervor:

DE 199 23 609 A 1

Tabelle 1

Typ_f(94) 4x/0.10 1.0 mm Ringfeld

ELEMENT	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
NUMMER				
OBJEKT	INF	0.000		
			204.000	
		100.228		
			217.084	
		380.421		
M1	A(1)	-380.421	284.271	REFL
M2	A(2)	380.421	583.054	REFL
			380.422	
		788.185		
		APERTUR-BLENDE	23.784	
M3	A(3)	-117.968	23.784	REFL
M4	A(4)	117.968	92.608	REFL
			71.790	
		284.483		
			89.622	
BILD	BILDWEITE=	-192.945		
	INF		50.989	

Asphärische Konstanten:

$$Z = \frac{(CURV) Y^2}{1 + (1 - (1 + K) (CURV)^2 Y^2)^{1/2}} + (A) Y^4 + (B) Y^6 + (C) Y^8 + (D) Y^{10}$$

Asphäre	CURV	K	A	B	C	D
A(1)	0.0014137	-4.843893	0.00000E+00	-8.87355E-15	7.87388E-20	0.00000E+00
A(2)	0.0011339	-0.232793	0.00000E+00	-5.35928E-17	3.35875E-23	0.00000E+00
A(3)	0.0040248	3.008878	0.00000E+00	3.76117E-13	-1.43488E-15	0.00000E+00
A(4)	0.0042182	0.289323	0.00000E+00	8.76473E-15	-5.59142E-19	0.00000E+00

Referenz Wellenlänge = 13 nm

Die Konstruktionsdaten des in Flg. 4 dargestellten Typ g-Systems gehen aus nachfolgender Tabelle 2 hervor:

DE 199 23 609 A 1

Tabelle 2

	ELEMENT	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
5	NUMMER				
	OBJEKT	INF	0.000		
				413.000	
10			378.925		
				373.842	
			474.829		
15	M1	A(1)	-474.829	327.612	REFL
	M2	A(2)	474.829	600.624	REFL
				208.076	
20			196.627		
			APERTUR-BLENDE	28.268	
25	M3	A(3)	-138.037	28.268	REFL
	M4	A(4)	138.037	141.438	REFL
				115.807	
30			-196.627		
				155.535	
			160.000		
35				123.208	
		BILDWEITE =	98.781		
	BILD	INF		103.302	

	ASPHÄRISCHE	CURV	K	A	B	C	D
	KONSTANTEN						
45	A(1)	0.0010894	-0.738027	0.00000E+00	3.65218E-16	-1.37411E-20	0.00000E+00
	A(2)	0.0012023	0.031851	0.00000E+00	1.38321E-17	-6.58953E-23	0.00000E+00
50	A(3)	0.0036831	1.579939	0.00000E+00	-1.28703E-13	3.53973E-16	0.00000E+00
	A(4)	0.0035917	0.316373	0.00000E+00	3.15592E-15	1.74158E-19	0.00000E+00
	REFERENZ-	13.0 nm					
	WELLEN-						
55	LÄNGE						

Bringt man zwischen Spiegel M1, M2 und M3, M4 einen Umlenkspiegel, einen sog. grazing incidence Spiegel GIM ein, so erhält man den in Fig. 5 dargestellten Aufbau vom Typ f. Die Daten dieser Ausführungsform sind Tabelle 3 zu entnehmen.

DE 199 23 609 A 1

Tabelle 3

Typ_f(xx) 4x/0.10 1.0 mm Ringfeld

ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
OBJEKT	INF	0.000		
			204.000	
		100.000		
			217.085	
		380.407		
M1	A(1)	-380.407	264.287	REFL
M2	A(2)	380.407	563.152	REFL
			390.481	
		288.123		
	DECENTER (1)			
GIM	INF	-499.985	538.341	REFL
		APERTUR-BLENDE	23.757	
M3	A(3)	117.888	23.757	REFL
M4	A(4)	-117.988	92.614	REFL
			69.580	
		-284.465		
	BILDWEITE=	192.894		
BILD	INF		51.000	

ASPHÄRISCHE KONSTANTE	CURV	K	A	B	C	D
N						
A(1)	0.0014140	-4.843298	0.00000E+00	-8.99188E-15	7.89877E-20	0.00000E+00
A(2)	0.0011341	-0.232835	0.00000E-00	-5.33514E-17	3.24688E-23	0.00000E+00
A(3)	-0.0040253	3.007585	0.00000E+00	-3.82589E-13	1.46212E-15	0.00000E+00
A(4)	-0.0042169	0.289286	0.00000E+00	-8.78770E-15	5.47269E-19	0.00000E+00
DECENTER KONSTANTEN						
DECENTER		Umlenkwinkel ALPHA				
		AM GIM				
D(1)				78.00000 Grad		
Wellenlänge 13 nm						

Mit der Erfindung wird somit erstmals ein 4-Spiegel-Projektionsobjektiv mit einem Abbildungsmaßstab von vorzugsweise 4x für den bevorzugten Einsatz in einem EUV Ringfeldprojektionssystem angegeben, das sowohl die notwendige Auflösung bei gefordertem Bildfeld wie auch Konstruktionsbedingungen aufweist, welche eine funktionsgerechte Bauausführung ermöglichen, da die Asphären hinreichend mild, die Winkel hinreichend klein für die Schichten und die Bau-
räume für die Spiegelträger hinreichend groß sind.

Patentansprüche

1. Reduktionsobjektiv insbesondere der EUV-Mikrolithographie, mit
 - vier Multilayer-Spiegeln (M1, M2, M3, M4) in zentrierter Anordnung bezüglich einer optischen Achse, mit
 - Primär-, Sekundär-, Tertiär-, Quartärspiegel in dieser Reihenfolge im Strahlengang
 - Ringfeld geeignet für Scanning-Betrieb,
 - obskurationsfreier Lichtführung,
 gekennzeichnet durch
 - einen konvexen Primärspiegel (M1),
 - positive Hauptstrahlwinkelvergrößerung des Sekundärspiegels (M2).
2. Reduktionsobjektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (B) auf oder nahe einem Spiegel liegt, insbesondere dem Tertiärspiegel (M3).
3. Reduktionsobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich ein oder zwei Spiegel (GIM) in streifendem Einfall angeordnet sind.
4. Reduktionsobjektiv nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die zusätzlichen Spiegel (GIM) von einer Planfläche abgeleitete asphärische Flächen aufweisen.
5. Reduktionsobjektiv nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Spiegel (GIM) ein aktiver Spiegel ist.
6. Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, daß der Sekundärspiegel (M2) und der Quartärspiegel (M4) konkav sind.
7. Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–6, dadurch gekennzeichnet, daß die Multilayer-Spiegel (M1, M2, M3, M4) in der Reihenfolge konvex-konkav-konvex-konkav ausgebildet sind.
8. Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet, daß es objektseitig telezentrisch ist.
9. Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet, daß der Hauptstrahl (CR) am Objekt (2) von der optischen Achse (HA) weg läuft.
10. Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–9, dadurch gekennzeichnet, daß es bildseitig telezentrisch ist.
11. Projektionsbelichtungsanlage mit einem Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Reflexionsmaske vorgesehen ist.
12. Projektionsbelichtungsanlage mit einem Reduktionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1–10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Transmissionsmaske vorgesehen ist.
13. Verfahren für Chipherstellung mit einer Projektionsbelichtungsanlage gemäß einem der Ansprüche 11–12.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

FIG. 1

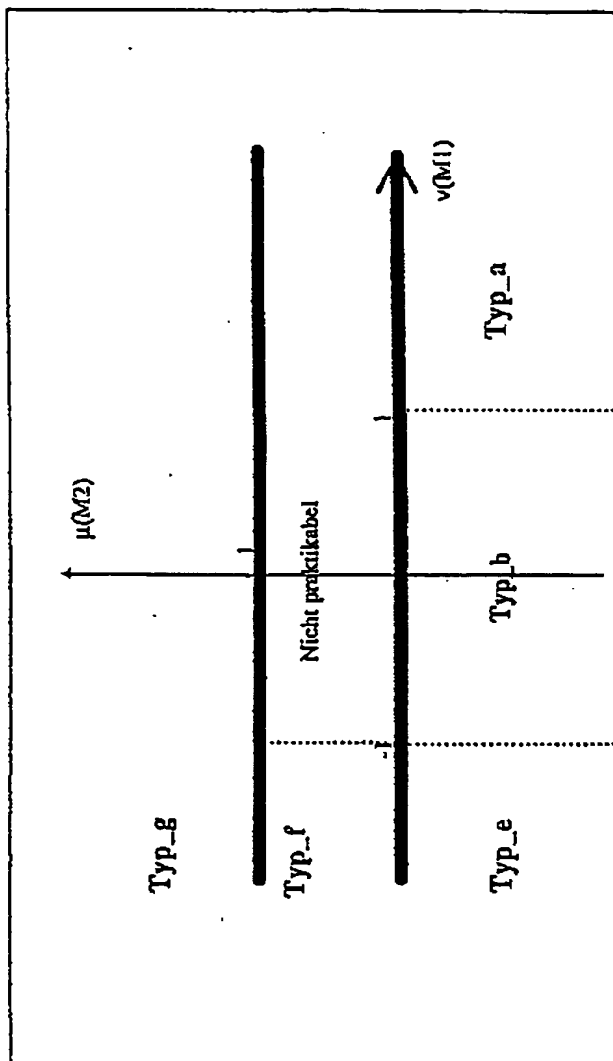
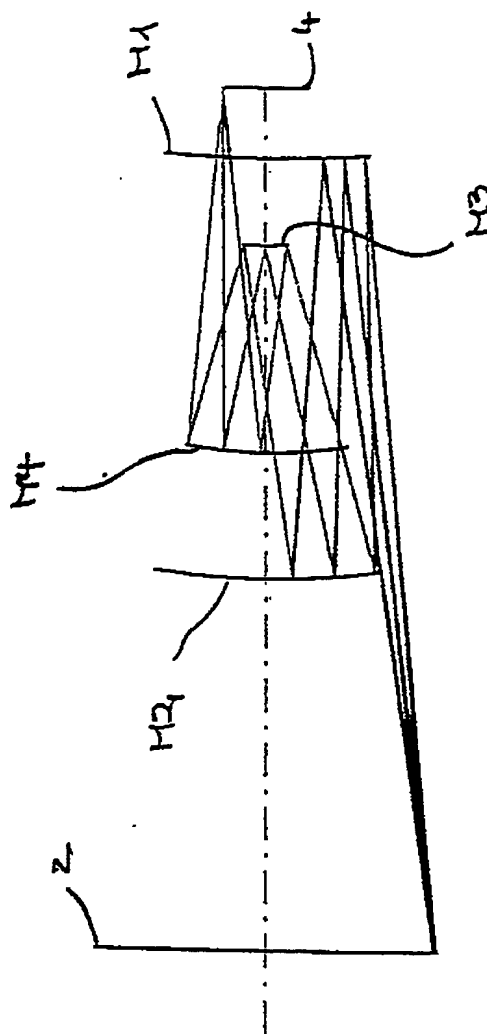


Fig. 2



200.00 mm

FIG. 3

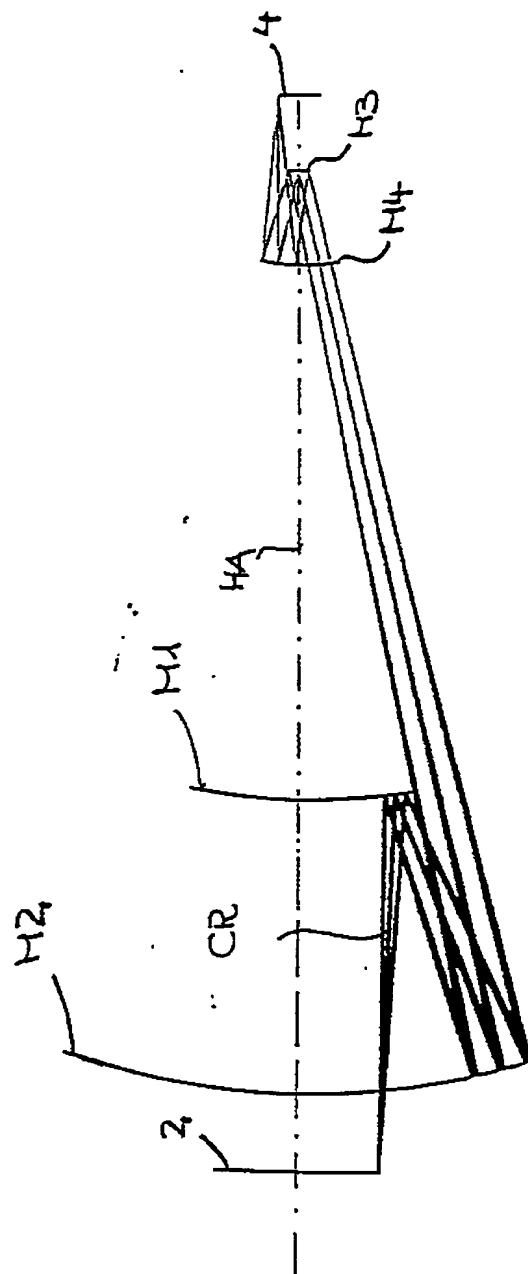


FIG. 4

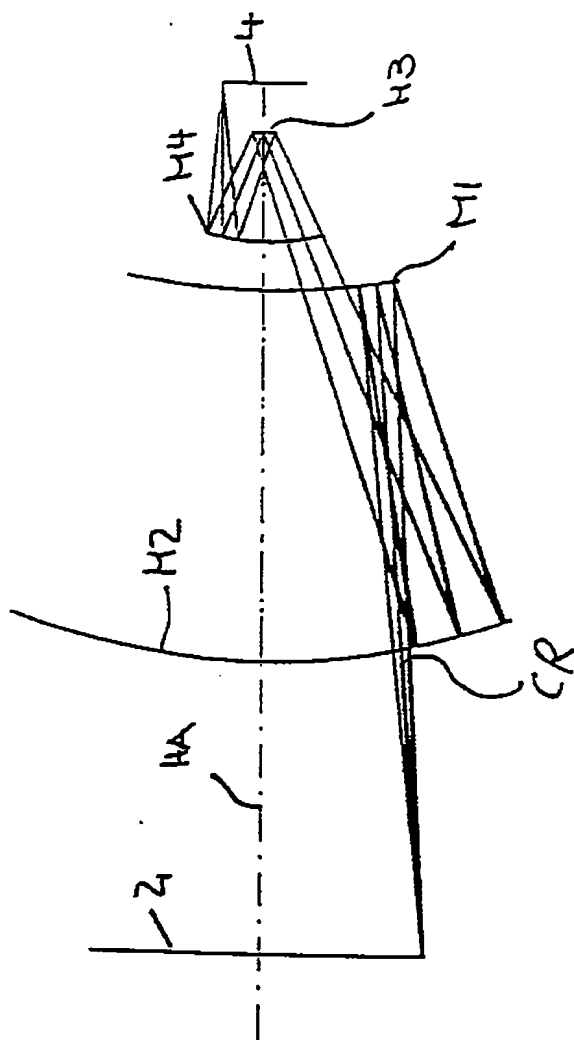


FIG. 5

